

Dostarczenie elementów zgodnych z opisem:

1. Ceramiczny kondensator wielowarstwowy SMD - Pojemność: 0.1 μ F; Napięcie znamionowe: 10V; Obudowa kondensatora ceramicznego: 0402 [jedn. metryczne: 1005]; Tolerancja pojemności: +80%, -20%; Charakterystyka dielektryka: Y5V - sztuk 1100
2. Ceramiczny kondensator wielowarstwowy SMD - Pojemność: 12pF; Napięcie znamionowe: 25V; Obudowa kondensatora ceramicznego: 0402 [jedn. metryczne: 1005]; Tolerancja pojemności: \pm 5%; Charakterystyka dielektryka: C0G / NP0 - sztuk 300
3. Dioda małosygnalowa Schottky'ego - Konfiguracja diody: Podwójna, poł. szeregowo; Powtarzalne napięcie wsteczne V_{rrm} , maks.: 30V; Prąd przewodzenia $I_f(AV)$: 200mA; Napięcie przewodzenia V_F , maks.: 800mV; Prąd udarowy przewodzenia I_{fsm} , maks.: 600mA; Temperatura robocza, maks.: 150°C; Rodzaj obudowy diody: SOT-323; Liczba pinów: 3piny/-ów - sztuk 150
4. Bipolarny (BJT) tranzystor pojedynczy, uniwersalny - Biegunowość tranzystora: NPN; Napięcie kolektor - emiter $V_{(br)ceo}$: 65V; Częstotliwość przejścia f_t : 100MHz; Straty mocy P_d : 150mW; Prąd kolektora DC: 100mA; Wzmocnienie prądu DC h_{FE} : 100hFE; Rodzaj obudowy tranzystora: SOT-323; Liczba pinów: 3piny/-ów - sztuk 500
5. Rezystor SMD, grubowarstwowy - Typ obudowy rezystora: 0402 [jedn. metryczne: 1005]; Rezystancja: 1.8Mohm; Asortyment produktów: Seria RC; Napięcie znamionowe: 50V; Typ elementu rezystora: Grubowarstwowe; Moc znamionowa: 63mW - sztuk 200
6. Rezystor SMD, grubowarstwowy - Typ obudowy rezystora: 0402 [jedn. metryczne: 1005]; Rezystancja: 100ohm; Asortyment produktów: Seria MCWR; Napięcie znamionowe: 50V; Typ elementu rezystora: Grubowarstwowe; Moc znamionowa: 62.5mW - sztuk 300
7. Kryształ - Częstotliwość, znamionowa: 32.768kHz; Obudowa kwarcu: SMD, 3.2mm x 1.5mm; Pojemność obciążenia: 12.5pF; Tolerancja częstotliwości + / -: 20ppm; Asortyment produktów: Seria CFPX-217 - sztuk 140
8. Tranzystor MOSFET - Biegunowość tranzystora: Kanał N; Prąd ciągły I_d drenu: 4.9A; Napięcie drenu / źródła V_{ds} : 30V; Rezystancja przewodzenia $R_{ds(on)}$: 0.035ohm; Napięcie V_{gs} pomiaru $R_{ds(on)}$: 4.5V; Napięcie progowe V_{gs} : 400mV; Straty mocy P_d : 1.3W; Rodzaj obudowy tranzystora: SOT-23; Liczba pinów: 3piny/-ów - sztuk 150
9. Ceramiczny kondensator wielowarstwowy SMD - Pojemność: 10 μ F; Napięcie znamionowe: 10V; Obudowa kondensatora ceramicznego: 0805 [jedn. metryczne: 2012]; Tolerancja pojemności: \pm 10%; Charakterystyka dielektryka: X5R; Asortyment produktów: Seria GRM - sztuk 550
10. Rezystor SMD, grubowarstwowy - Typ obudowy rezystora: 0402 [jedn. metryczne: 1005]; Rezystancja: 1kohm; Asortyment produktów: Seria ASC; Napięcie znamionowe: 50V; Typ elementu rezystora: Grubowarstwowe; Moc znamionowa: 63mW - sztuk 500
11. Dioda LED 1.6mm x 0.8mm - Kolor LED: Czerwony; Montaż diody LED: SMD; Rozmiar żarówki: - Prąd przewodzenia I_f : 2mA; Napięcie przewodzenia: 1.8V; Długość fali, typ.: 625nm; Natężenie światła: 40mcd; Kąt świecenia: 120°; Kształt soczewki: Prostokątne - sztuk 150
12. Rezystor SMD, grubowarstwowy - Typ obudowy rezystora: 0603 [jedn. metryczne: 1608]; Rezystancja: 1.6kohm; Asortyment produktów: Seria ERJ3G; Napięcie znamionowe: 75V; Typ elementu rezystora: Grubowarstwowe; Moc znamionowa: 100mW - sztuk 150

13. Bezpiecznik - Typ bezpiecznika: topikowy; Charakterystyka bezpiecznika: superszybki; Rodzaj bezpiecznika: miniaturowy, osiowy; Prąd znamionowy: 250mA; Napięcie znamionowe: 125V; Rozmiar bezpiecznika: 2,8x7,1mm - sztuk 200

14. Obudowa - Typ obudowy: do alarmu; Wymiar X: 85mm; Wymiar Y: 85mm; Wymiar Z: 35.5mm; Materiał obudowy: ABS; Kolor obudowy: biały - sztuk 135

15. Gniazdo - Typ złącza: kołkowe; Rodzaj złącza: żeńskie; Ilość pinów: 4; Orientacja przestrzenna: proste; Raster styków: 2.54mm; Montaż elektryczny: THT; Układ wyprowadzeń złącza: 1x4; Pokrycie styku: złocony; Wymiary wyprowadzeń dł. 3mm; Prąd maksymalny: 3A; Temperatura lutowania: 220°C; Wysokość: 5mm - sztuk 50

16. Gniazdo - Typ złącza: kołkowe; Rodzaj złącza: żeńskie; Ilość pinów: 2; Orientacja przestrzenna: kątowne 90°; Raster styków: 2.54mm; Montaż elektryczny: THT; Układ wyprowadzeń złącza: 1x2; Pokrycie styku: złocony; Wymiary wyprowadzeń: dł. 3.2mm; Prąd maksymalny: 3A; Wysokość: 8.4mm - sztuk 150

17. Listwa kołkowa - Typ złącza: kołkowe; Rodzaj złącza: męskie; Ilość pinów: 40; Orientacja przestrzenna: proste; Raster styków: 2.54mm; Montaż elektryczny: THT; Układ wyprowadzeń złącza: 1x40; Pokrycie styku: gold flash; Wymiary wyprowadzeń: dł. 3mm - sztuk 50

18. Styk - Typ złącza: kołkowe; Rodzaj złącza: żeńskie; Rozmiar przewodu: 28...26AWG; Seria złącza: C-Grid III; Pokrycie styku: cynowany; Montaż elektryczny: zaciskanie; Prąd maksymalny: 3A - sztuk 500

19. Gniazdo - Typ złącza: kołkowe; Rodzaj złącza: żeńskie; Ilość pinów: 10; Orientacja przestrzenna: proste; Raster styków: 1.27mm; Montaż elektryczny: THT; Układ wyprowadzeń złącza: 2x5; Pokrycie styku: gold flash; Prąd maksymalny: 1A; Rezystancja styku maks.: 30mΩ - sztuk 20

20. Pojemnik - Rozmiar ogniwa: MR18650; Montaż: SMT; Ilość baterii: 1 - sztuk 200

21. Akumulatory litowo-jonowe (Li-ION) - napięcie: 3,6V; maksymalne napięcie ładowania: 4.20 ± 0.05 V; minimalne napięcie rozładowania: 2.5V; pojemność minimalna: 3400mAh; pojemność nominalna: 3500mAh; standardowy prąd ładowania: 1700mA; maksymalny prąd ładowania: 3400mAh; standardowy prąd rozładowania: 680mA; maksymalny prąd rozładowania: 5A; wbudowany układ zabezpieczenia nadprądowego: 6,5A; czas ładowania: ok. 4 h; wewnątrz ogniwo LG INR18650MJ1 3500mAh Li-ION; - sztuk 200

22. Cewka indukcyjna - Styl zakończenia: SMD / SMT; Indukcyjność: 15μH; Prąd RMS (Irms): 820mA; Budowa cewki indukcyjnej: Drutowe; Prąd nasycenia (Isat): 670mA; Asortyment produktów: Seria VLS-CX; Obudowa cewki indukcyjnej mocy: 2.5mm x 2mm x 1.2mm; Rezystancja DC, maks.: 0.772ohm; Tolerancja indukcyjności: ± 20% - sztuk 150

23. Tranzystor - Technologia: Si; Sposób montażu: SMD / SMT; Pakiet / obudowa: SOT-23-3; Liczba kanałów: 1 kanał; Biegunowość tranzystora: P-Channel; Vds - Napięcie przebicia źródła: 20 V; Id - Ciągły prąd drenujący: 4 A; Rds On - Odporność na działanie drenu: 50 mOhms; Vgs th - Napięcie próg źródła bramki: 1 V; Vgs - Napięcie źródła bramki: 8 V; Qg - Gate Charge: 17,2 nC; Minimalna temperatura robocza: - 55 ° C; Maksymalna temperatura robocza: + 150 C; Konfiguracja: Pojedynczy - sztuk 420

24. Pamięć - Rodzaj pamięci: EEPROM; Interfejs: I2C; Organizacja pamięci: 8kx8bit; Napięcie pracy: 1.7...5.5V; Częstotliwość taktowania: 400kHz; Montaż: SMD; Obudowa: SOT23-5; Pojemność pamięci: 64kbit; Temperatura pracy -40...85°C - sztuk 150

25. Czujnik wilgotności i temperatury SMD - Zakres działania od 0 do 100% RH; Zakres pracy w zakresie od -40 do +125 °C; Szerokie napięcie robocze (1,9 do 3,6 V); Niski pobór mocy: 150 µA aktywny prąd, 60 nA prądu spoczynkowego; - sztuk 145

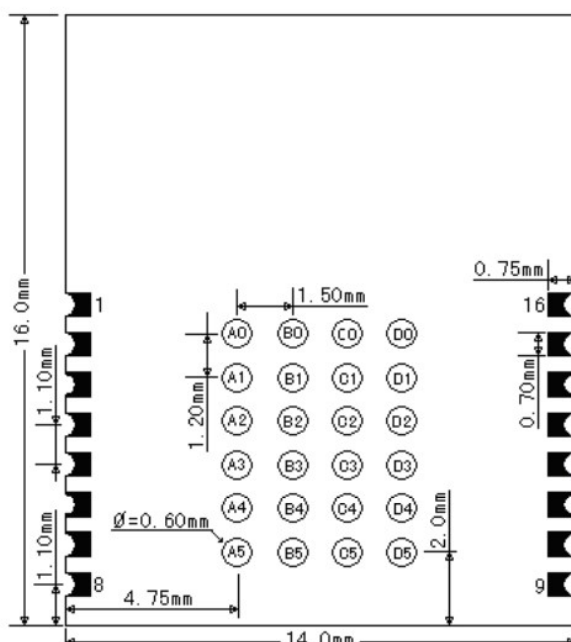
26. Przełącznik analogowy - Rodzaj układu: scalonego demultiplekser/ multiplekser, przełącznik; Liczba kanałów: 1; Liczba wyjść: 1; Obudowa: SC70-6; Napięcie zasilania: 1.65...5.5V DC; Montaż: SMD; Rodzaj opakowania: rolka, taśma; Temperatura pracy: -40...85°C; Prąd spoczynkowy: 10µA; Rodzaj wyjścia: SPDT; Liczba wejść: 3 - sztuk 280

27. Regulator przełączający DC-DC (step-down) - Napięcie wejściowe, min.: 3V; Napięcie wyjściowe, maks.: 17V; Liczba wyjść: 1wyjść/-ia; Rodzaj obudowy przetwornicy DC / DC: WSON; Liczba pinów: 8piny/-ów; Prąd wyjściowy: 300mA; Napięcie wyjściowe, min.: 1.2V; Napięcie wyjściowe, maks.: 10V; Częstotliwość przełączania: 1MHz; Temperatura robocza, maks.: 85°C - sztuk 145

28. Ładowarka sieciowa 2xUSB z kablem microUSB - Port USB: x 2; Wejście: AC100 - 240 V, 0.3 A, 50 / 60 Hz; Wyjście: Port nr 1: DC 5V, 1A; Port nr 2: DC 5V, 2A; Prąd całkowity: 2A; Kompatybilne z: wszystkie urządzenia z wejściem microUSB - sztuk 3

29. Radio bluetooth MidRange – sztuk 130

- Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0
- Wbudowany mikrokontroler zgodny z ARM Cortex-M4/M4F
- Stos Bluetooth umożliwiający tworzenie sieci Mesh zgodnie ze specyfikacją Bluetooth Mesh Profile v1.0 (2017-Jul-13) opracowaną przez Mesh Working Group
- Obsługa tagów NFC-A
- Interfejs SWD
- Minimum 1x interfejs UART
- Minimum 2x interfejsy I2C
- Minimum 1x interfejs SPI
- Minimum 2 kanały przetwornika ADC o rozdzielczości minimum 12-bit
- Minimum 12 portów GPIO
- Minimum jeden kanał PWM
- Zasilanie w granicach 2,5V - 3,3V
- Praca w zakresie temperatur przemysłowych (-40°C do 85°C)
- Zasięg radia na otwartej przestrzeni do 250 metrów
- Raster wyprowadzeń mikrokontrolera zgodny z:



30. Radio bluetooth LongRange – sztuk 10

- Radio Bluetooth kompatybilne z wersją 5.0
- Wbudowany mikrokontroler zgodny z ARM Cortex-M4/M4F
- Stos Bluetooth umożliwiający tworzenie sieci Mesh zgodnie ze specyfikacją Bluetooth Mesh Profile v1.0 (2017-Jul-13) opracowaną przez Mesh Working Group
- Obsługa tagów NFC-A
- Interfejs SWD
- Minimum 1x interfejs UART
- Minimum 2x interfejsy I2C
- Minimum 1x interfejs SPI
- Minimum 2 kanały przetwornika ADC o rozdzielczości minimum 12-bit
- Minimum 12 portów GPIO
- Minimum jeden kanał PWM
- Zasilanie w granicach 2,5V - 3,3V
- Praca w zakresie temperatur przemysłowych (-40°C do 85°C)
- Zasięg radia na otwartej przestrzeni do 1000 metrów
- Raster wyprowadzeń mikrokontrolera zgodny z:

